查询2SA941供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

2SA941
2SA942

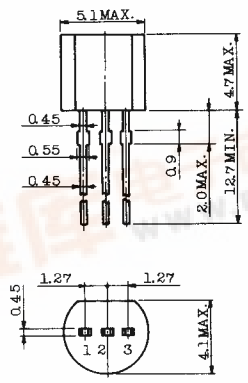
シリコンPNPエピタキシアル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

○ 低周波低雑音増幅用

○ Low Noise Audio Amplifier Applications.

- 高耐圧です。： V_{CEO}=−120V(2SA941),−90V(2SA942)
- 雑音指数が小さい。： NF=6dB(Max.)
  (R_g=10kΩ, f=10Hz)(2SA941)
- パルス性雑音が小さい。
- 直流電流増幅率が高い。： h_{FE}=200〜700
- プリアンプおよびメインアンプ初段増幅に適しています。
- 2SC2088, 2SC2089 とコンプリメンタリになります。

Unit in mm



1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE

JEDEC	TO−92
EIAJ	SC−43
TOSHIBA	2−5F1B

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SA941	V_{CBO}	−120	V
	2SA942		−90	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA941	V_{CEO}	−120	V
	2SA942		−90	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流		I_C	−50	mA
エミッタ電流		I_E	50	mA
コレクタ損失		P_C	300	mW
接合温度		T_j	125	℃
保存温度		T_{stg}	−55〜125	℃

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流		I_{CBO}	V_{CB}=−120V(A941) V_{CB}=−90V(A942), I_E=0	−	−	−0.1	μA
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	V_{EB}=−5V, I_C=0	−	−	−0.1	μA
直流電流増幅率		h_{FE} (Note)	V_{CE}=−6V, I_C=−2mA	200	−	700	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	I_C=−10mA, I_B=−1mA	−	−	−0.4	V
ベース・エミッタ間電圧		V_{BE}	V_{CE}=−6V, I_C=−2mA	−	−0.65	−	V
トランジション周波数		f_T	V_{CE}=−6V, I_C=−1mA	−	150	−	MHz
コレクタ出力容量		C_{ob}	V_{CB}=−10V, I_E=0, f=1MHz	−	2.8	−	pF
雑音指数	2SA941	NF	V_{CE}=−6V, I_C=−0.1mA R_g=10kΩ, f=10Hz	−	1.0	6.0	dB
	2SA942		V_{CE}=−6V, I_C=−0.1mA R_g=10kΩ, f=100Hz	−	−	6.0	

Note : h_{FE} 区分/h_{FE} classification GR : 200〜400, BL : 350〜700

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com